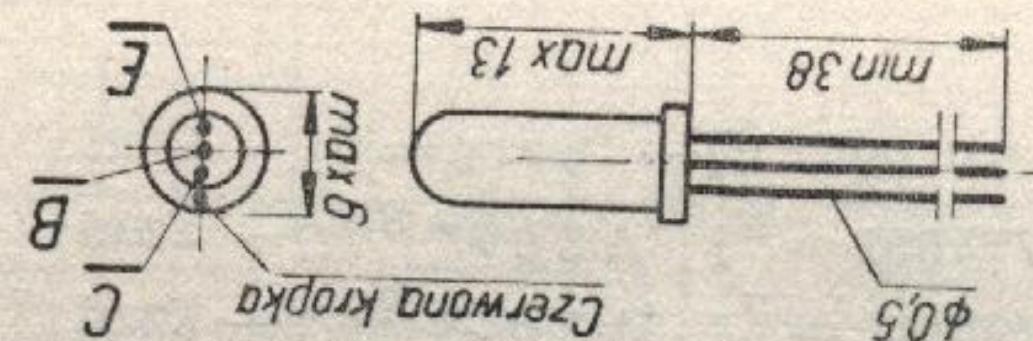


\* Przewiduje się wycofanie z produkcji.

Szkic rozmiarowy tranzystora TG9



(PNP)

Tranzystor germanowy stopowy TG9\*

Tranzystor germanowy stopowy TG9 jest tranzystorem małej mocy, małej częstotliwości, przeznaczonym głównie do pracy w układach impulsowych.

Obudowę ma metalową. Ciężar jego wynosi najwyżej 0,9 G.

#### Dane maksymalne (wartości graniczne)

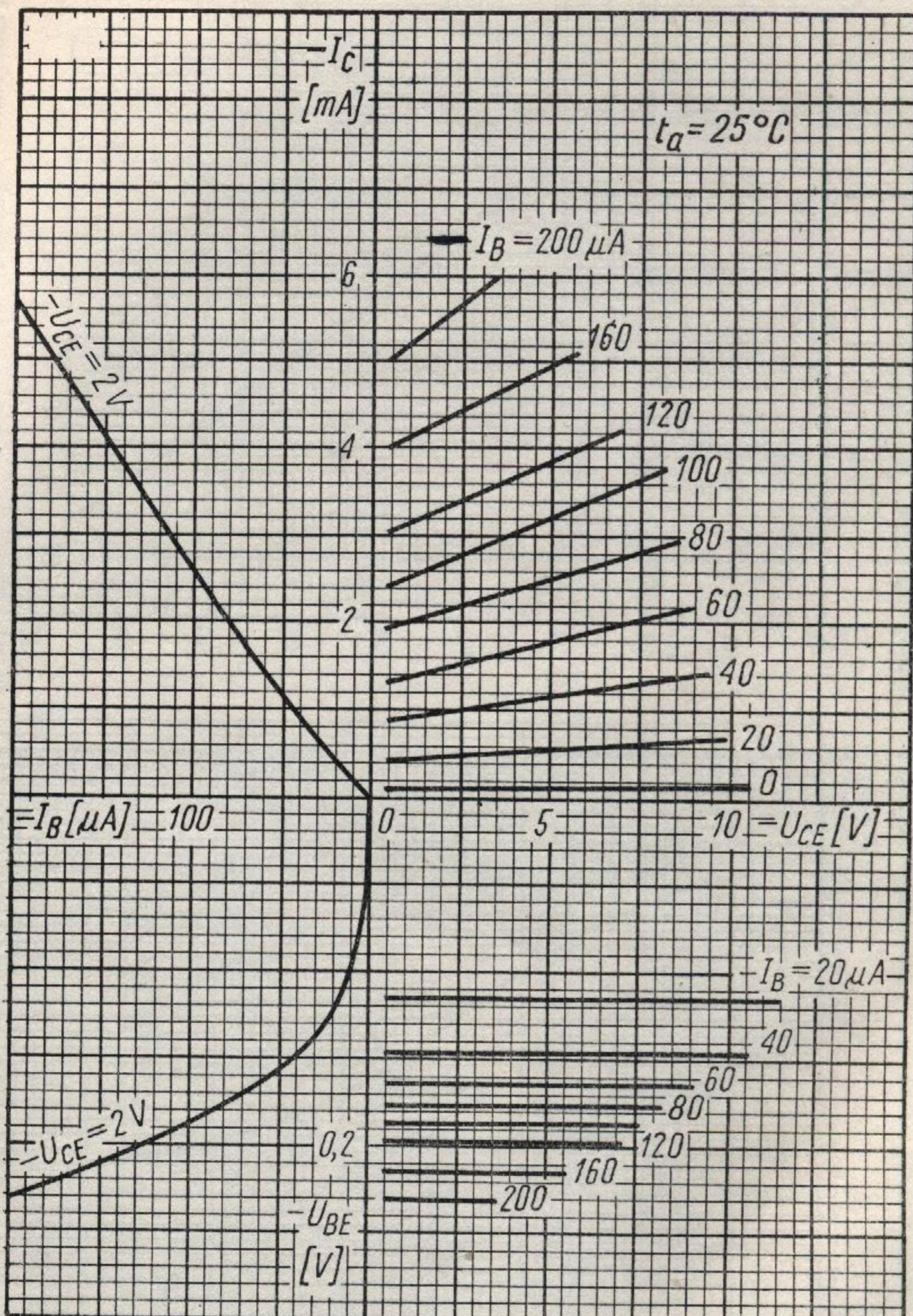
$-U_{CBM\ max}$	= 15 V
$-U_{CEM\ max}$	= 15 V
$-U_{CEM\ max}$	zob. wykresy na stronie 74.
$-U_{CE\ max}$	
$-U_{EBM\ max}$	= 6 V
$-U_{EB\ max}$	= 6 V
$-I_{CM\ max}$	= 125 mA najwyżej przez 20 ms
$-I_C\ max$	= 50 mA
$I_{EM\ max}$	= 125 mA najwyżej przez 20 ms
$I_E\ max$	= 50 mA
$-I_{BM\ max}$	= 50 mA najwyżej przez 20 ms
$-I_B\ max$	= 25 mA
$P_{max}$	— zob. wykresy na stronie 75.
$t_j\ max$	= 75°C
$R_t$	= 0,6 deg/mW

#### Dane statyczne ( $t_a = 25^\circ\text{C}$ )

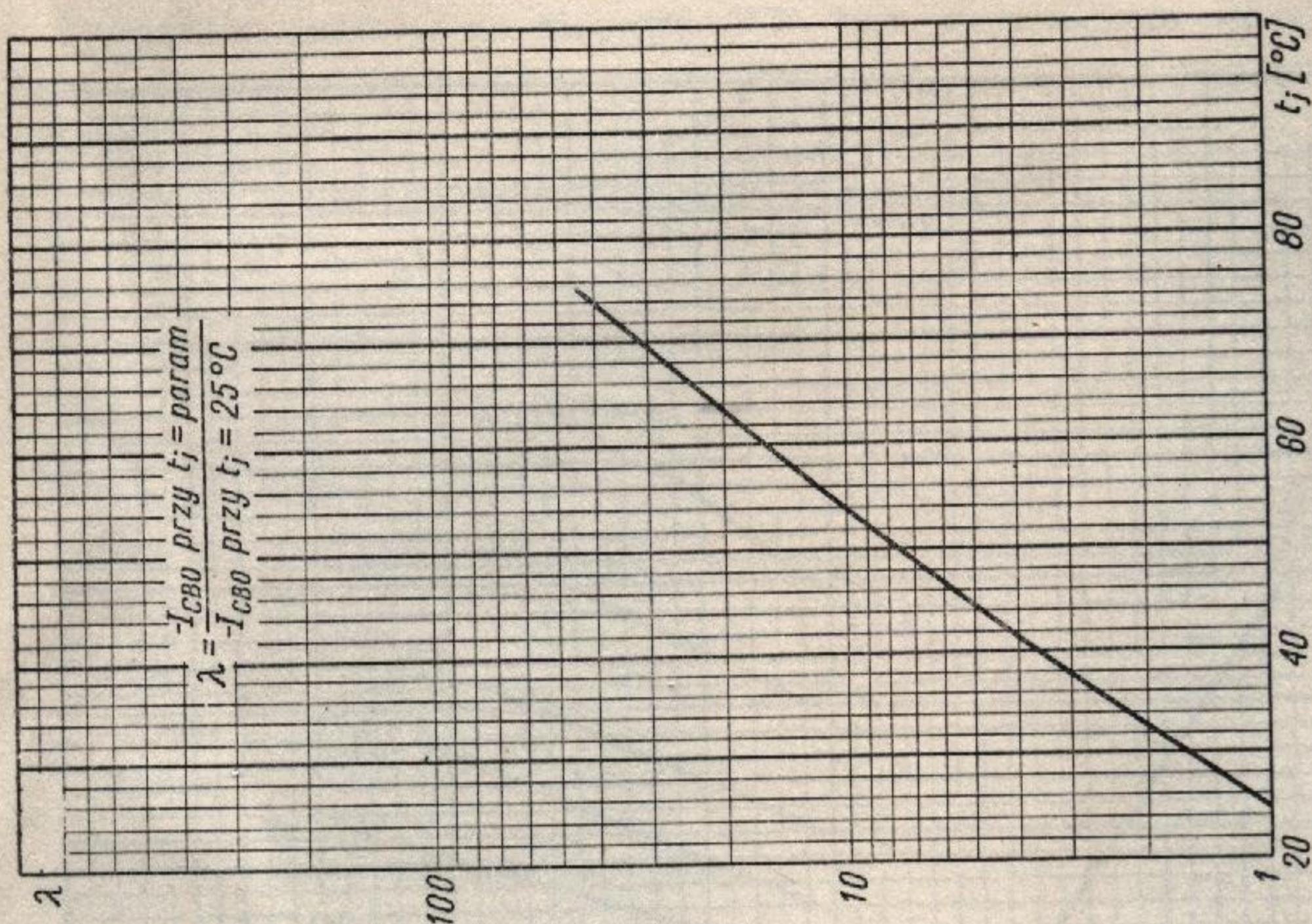
$-I_{CB0} \leq 5 \mu\text{A}$	przy $-U_{CB} = 6 \text{ V}$
$-I_{CB0} \leq 50 \mu\text{A}$	przy $-U_{CB} = 15 \text{ V}$
$-I_{C0K} \leq 50 \mu\text{A}$	przy $-U_{CE} = 15 \text{ V}$
$-I_{EB0} \leq 5 \mu\text{A}$	przy $-U_{EB} = 6 \text{ V}$
$-I_{EB0} \leq 50 \mu\text{A}$	przy $-U_{EB} = 10 \text{ V}$
$h_{21E} \geq 20$	przy $-U_{CB} \leq 0,2 \text{ V}$ , $I_E = 10 \text{ mA}$
$h_{21E} \geq 10$	przy $-U_{CB} \leq 0,2 \text{ V}$ , $I_E = 100 \text{ mA}$
$-U_{CE\ sat} \leq 0,25 \text{ V}$	przy $-I_B = 3 \text{ mA}$ , $-I_C = 50 \text{ mA}$

#### Dane dynamiczne ( $t_a = 25^\circ\text{C}$ )

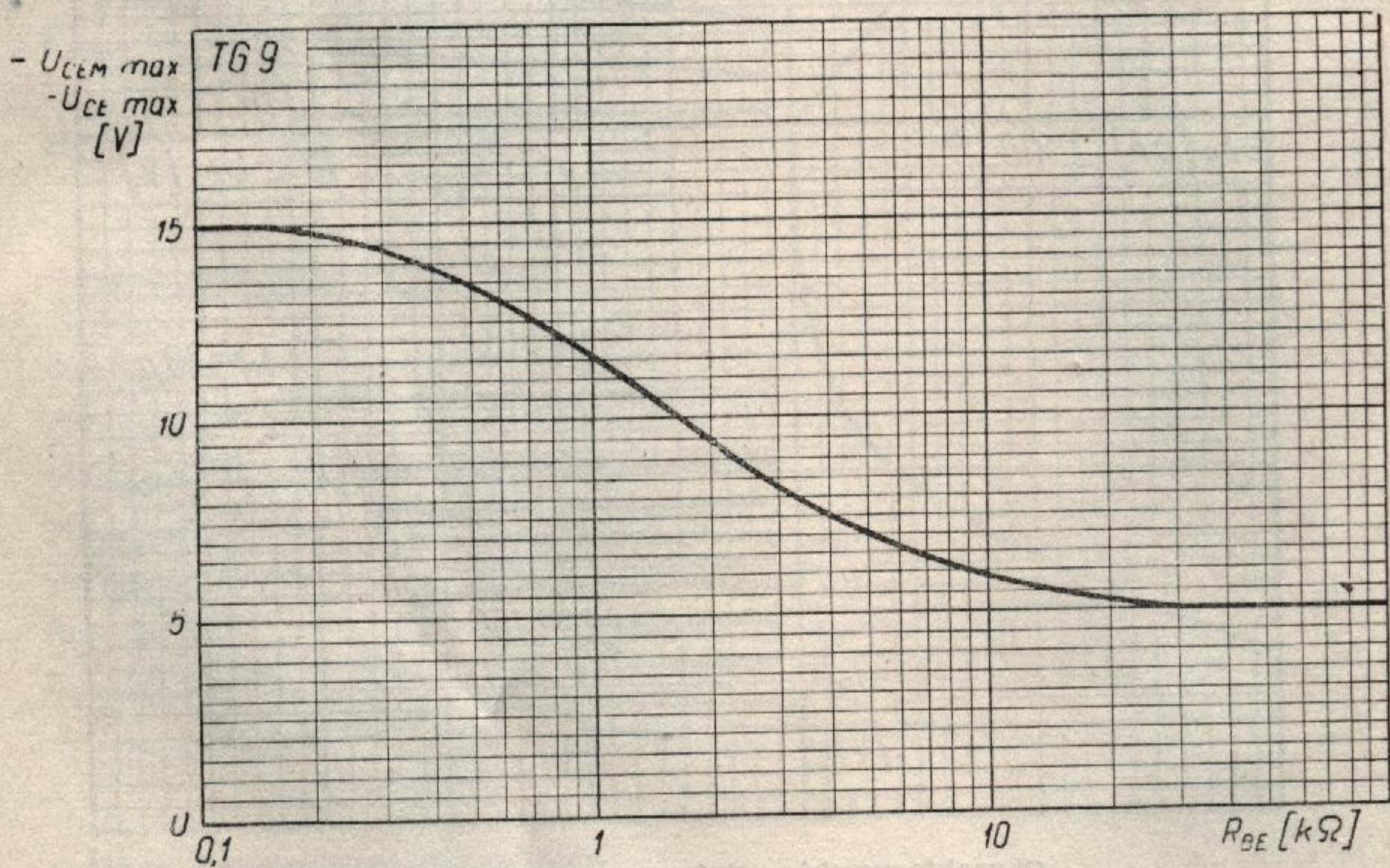
$$f_a \geq 1,5 \text{ MHz} \text{ przy } -U_{CB} = 6 \text{ V}, \quad I_E = 3 \text{ mA}$$



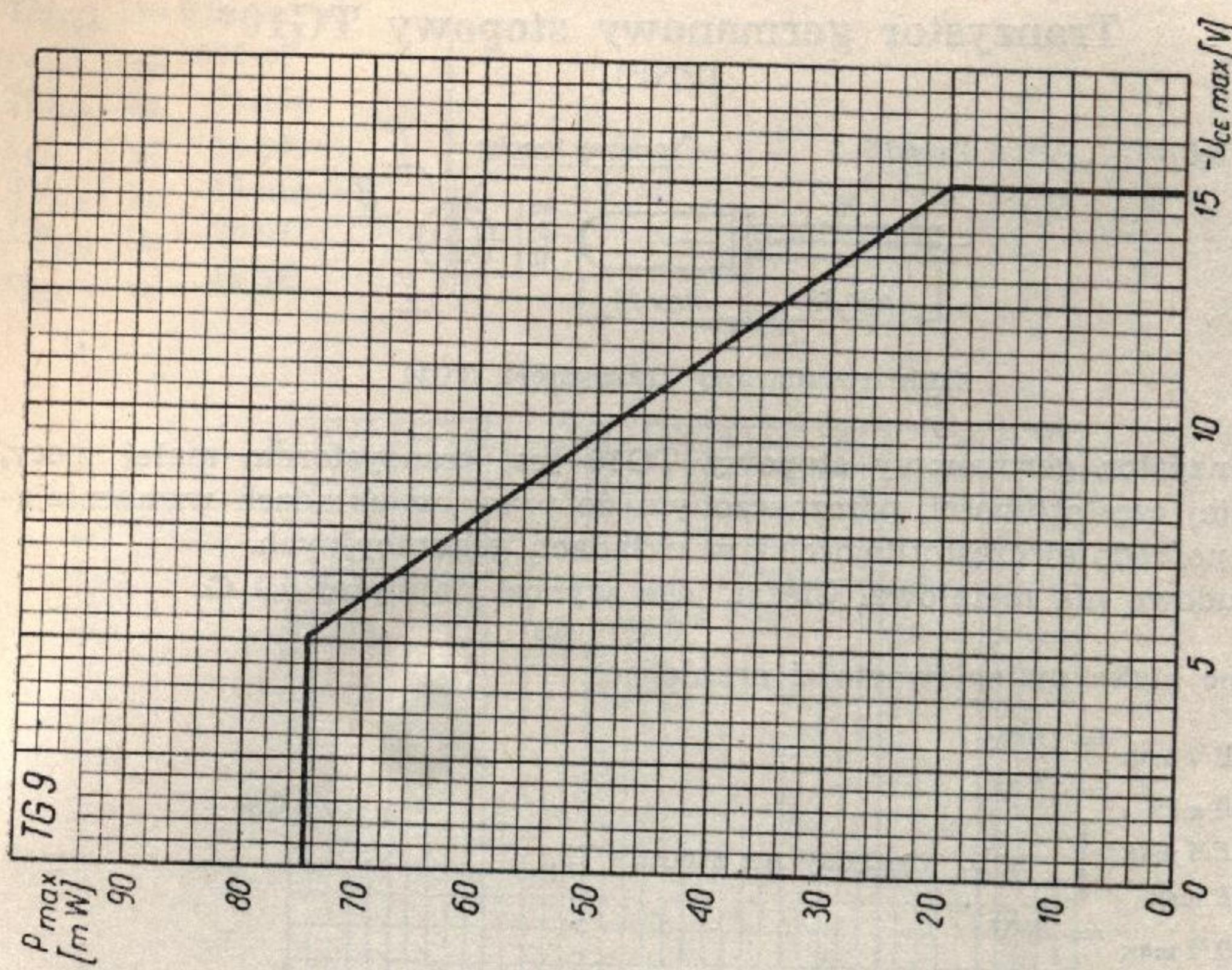
Charakterystyki statyczne tranzystora TG9



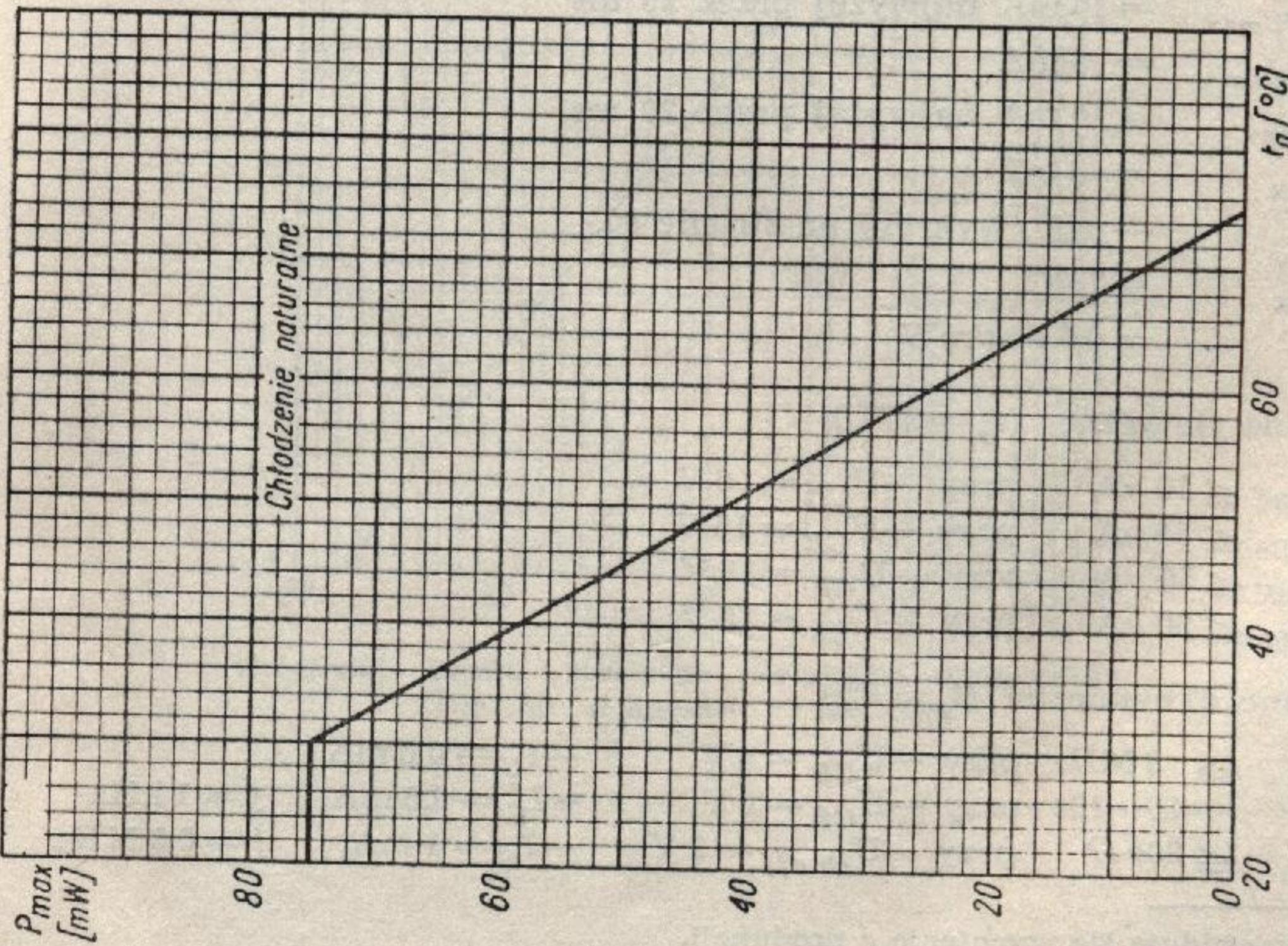
Zależność prądu zerowego kolektora tranzystora TG9 od temperatury złącza



Zależność maksymalnego napięcia kolektor-emiter tranzystora TG9 od rezystancji między bazą a emiterem



Zależność maksymalnej mocy strat tranzystora TG9 od maksymalnego napięcia kolektor-emiter



Zależność maksymalnej mocy strat tranzystora TG9 od temperatury otoczenia